### ⑲ 日本国特許庁(JP)

⑪特許出願公開

# ⑫ 公 開 特 許 公 報 (A)

昭63-31006

Mint Cl.

識別記号

庁内整理番号

⑩公開 昭和63年(1988)2月9日

G 11 B 5/127.

6538-5D

審査請求 未請求 発明の数 3 (全1頁)

❷発明の名称

磁気ヘッド素子及びその駆動方法並びにその製造方法

创特 頤 昭61-174492 願 昭61(1986)7月23日 22出

砂発 明 者 浦 井 東京都港区芝5丁目33番1号 日本電気株式会社内

治 雄 日本電気株式会社 の出願 人

東京都港区芝5丁目33番1号

20代 理 弁理士 内 原

発明の名称

磁気ヘッド素子及びその駆動方法 並びにその製造方法

#### 特許請求の範囲

- 1. 長手方向に一軸磁気異方性をもつ軟強磁性体 パタンと、該軟強磁性体パタンの両端部近傍及 び中央部に巻線を形成することを特徴とする磁 気ヘッド素子。
- 2. 軟強磁性体パタンの中央部に付した巻線密度 が、その両端部の巻線密度に比して高いことを 特徴とする特許請求の範囲第1項記載の磁気へ ッド索子。
- 3. 軟強磁性体パタンに沿って、他の軟強磁性パ タンを配することを特徴とする特許請求の範囲 第1項又は第2項記載の磁気ヘッド素子。
- 4. 具手方向に一軸磁気異方性をもつ軟強磁性体 パタンと、その両端部近傍及び中央部に形成し

た巻線とを備えた磁気ヘッド素子の駆動方法に 於いて、両端部近傍の巻線には、互いに極性の 異なる磁界を発生する直流電流を印加し、中央 部の巻線の両端の電圧変化を検出することによ り、前記軟強磁性体パタンに加わる交番磁界を 検出し、又は、前記両端部近傍の巻線に同極性 の磁界を発生する電流パルスを印加することに より、前記軟強磁性体パタンの端部よりパルス 状磁界を発生させることを特徴とする磁気ヘッ ド素子駆動方法。

- 5. 基板材料上に第1の導体層を披着し、露光現 像エッチングによる第1の導体パタン形成後、 絶縁層を被着し平坦化加工処理を行ない、軟強 磁性体を被替パターニング後、絶縁層を被称 し、第1の導体パタンに達するパイアホール形 成し、しかる後に第2の導体層を被着しパタニ ングすることを特徴とする磁気ヘッド案子製造 方法。
- 6. バイアホール形成後、第1の事体パタンを選 極として電気メッキ若くは無弧解メッキ法によ

りバイアホールを埋めることを特徴とする特許 請求の範囲第5項記載の磁気ヘッド素子製造方法。

#### 発明の詳細な説明

#### (産業上の利用分野)

本発明は、局所的な交番磁界の検出及び発生手段に関するものである。更に詳しく述べれば、循めて狭トラックの磁気記録用磁気ヘッドに関するものである。

#### (従来の技術)

 スペース時に問題が生じる。このため、外部ファイルメモリとしての磁気記録に於いては、情報記憶密度の向上がその大きな技術課題であった。

薄膜磁気ヘッドの一般的形状は第7図に示す様に、基板材料3の上に二層の軟強磁性体パタン1'によりヨークを形成し、その間に導体パタンで巻線2'を付すことによりなりたっている。この磁気

#### (発明が解決しようとする問題点)

上述の様に、従来の磁気記録技術では、主として、磁気ヘッドの寸法によって最大記憶密度が決まる。したがって、第7図に示したヘッド幅wを小さくすると、トラック密度を上げることが出来る答である。いま、第7図で示した従来の磁気ヘッドでは、銃み出し出力は約 300μ γ<sub>P-P</sub>である。トラック密度増大のためにwを小さくするとこの

出力は大幅に低下する。このため実質上の記憶密度の向上は望めない。本発明は、トラック密度の増大を可能とする詳しい磁気ヘッド常子を提供することを目的とするものである。

#### (問題点を解決するための手段)

# 特開昭63-31006 (3)

村料上に第1の導体層を被着し、露光現像エッチングによる第1の導体パタン形成後、絶縁層を被着し平坦化加工処理を行ない、軟強磁性体を被着パターニング後、絶縁層を被着し、第1の導体パタン(に達するバイアホールを形成し、しかる後に第2の導体層を被着しパターニングする磁気ヘッド素子の製造方法の提供である。

#### (実施例)

次に本発明について、図面を用いて説明する。本発明の磁気へッド素子の基本構成を第1図に示す。即ち、軟磁性体パタン1は、一軸に伸びた形状を呈しており、その異方性磁界Rxの方向は、パタンの長軸方向とほぼ一致している。この軟磁性体パタンの両端が11.12の一致には巻線21及び22が施されている。その中央部には、センス用巻線20が施されている。その中央部には、パタンの構発を必、高さhと定義しておく。 ロイの如き Ni-Fe合金、Ca-Zr 系等のアモルファス材料、 Pe-Si-A 2 の如きセンダスト材料等を用いる。

20を第3図(A) の様に施す。この巻線の巻数をNとすると、外部磁界Hの極性反転に伴ない、巻線部分の磁化が実質的に 2Ms変化する。ここでMsは飽和磁化の強さを表わす。この外部磁界Hの変化が時間もの対してH=Hocos2xftの形で表わされるとすると、巻線の両端に生じる誘導電圧eは次式で与えられる(第3図(B))。

= 2 m f · 2 × 4 m Ms × V × h × N

CC , f=20NH<sub>2</sub>, 4π N<sub>s</sub>=10<sup>4</sup>gauss=1Vb/m<sup>2</sup>,

V=1  $\mu$  m  $=10^{-6}$  m , h =0.5  $\mu$  m =0.5  $\times$   $10^{-6}$  m N=20 を代入すると、 e 与 2.5 m V が得られる。 即 ちピークトウピークで 2.5 m V の磁界検出出力が可能となる。従来の薄膜型ヘッドでは、この磁界検出出力は 0.3 m V 程度であるので、約 8 倍の出力改善が期待出来る。

それのみならず、 $v=1~\mu$ m であるので、トラック密度も、従来のトラック密度の16倍となり、総合的な磁気記録密度も約16倍即ち、 128 Mb/c  $\pi$   $\pi$ 

この磁気ヘッド素子の動作の原理を第1回、第 2 図及び第3 図を用いて説明する。磁性体パタン 1 の両端部11及び12に施した巻線21及び22を第1 図の様に接続線25で電気的に接続し、矢印に示す 方向に直流電流を印加する。すると第2図(A) に 示す様に磁性体パタン端部11及び12は磁化Nsで表 わされる様に互に異なる方向に磁化する。両端部 の巻線の密度とその総数が等しいと、この磁化の 強さは等しくなり、その結果軟磁性体パタンの中 央部には磁盤15が生じる。この状態の軟磁性体パ タンに外部より磁界 H が第2図(B) の矢印41で示 す方向に印加すると、矢印41に一致する磁化の向 きをもつ磁区が成長して、磁型15は△ 4 だけ移動 する。第2図(C) の様に、外部からの磁界Hが矢 印42で示す前例と逆の方向に印加されると、それ に伴って磁盤15は逆の方向に△ 2 移動する。△ g の大きさは、軟磁性体パタン両端部に印加される 磁界の強度で適当に調整出来る。

この磁壁が移動する範囲即ち、軟磁性体パタン 中央から± Δ 2 の幅 2 Δ 2 の範囲にセンス用巻線

得られる。これは、現在で最高の記録密度をもつ 光ディスクの約50Mb/cm²の2倍以上の記録密度で ある。

次に、本発明の磁気ヘッド素子の第2の実施例 を第4図、第5図を用いて説明する。第4図に示 す様に、軟強磁性体パタンの中央部の巻線20が、 軟磁性体パタンから大きく離れて施される場合、 軟磁性体パタンの中央部からは磁束が漏れ出し、 両端部11,12 へ戻る磁力線43は、中央部の巻線内 を再び通過することがある。この根な時には、参 線内での磁束の変化は小さくなり、結果として、 磁界の検出出力が低下する。この検出出力低下を 防ぐには、第5図に示す様に、軟磁性体パタン1 に沿って、その近傍に同じ軟磁性体で出来た補助 パタン10を設けることが効果的である。この補助 パタン10は、中央部巻線から充分に離れた位置に 配しておく、軟磁性パタン1の中央部から滑れ出 た磁力線は、その殆んどが補助パタン18に吸収さ れ、補助パタン内を還流する。従って戻りの磁力 線は、巻線部を通過することはなく、磁界検出出

力低下は生じない。

第6回に本発明に係る強に、 文明に係ると、 文明に係ると、 文明を表えのは、 文明を表えのは、 文明を表えのは、 文明を表えるは、 文明を表える。 一次のののでは、 文明を表える。 一次ののののでは、 文明を表える。 ないののでは、 文明を表える。 ないののでは、 文明を表える。 ないののでは、 文明を表える。 ないののでは、 文明を表える。 ないののでは、 文明を表える。 ないののでは、 文明を表える。 ないのでは、 ないのでは、 ないのでは、 対して、 ないので、 ないのでは、 はいので、 ないので、 ないいいので、 ないので、 ないのではいい、 ないので、 ないでいいでいいでいないでいでいないでいでいないでいないでいないでいないでいでいないでいないでいでいでいないでいでいないでいでいないで

次に本発明の磁気ヘッド素子の駆動法を第8図(A).(B) を用いて説明する。磁気記録に於ける磁気へッド素子の役割は、磁気記録媒体に書き込まれた磁区情報の読み出しと、磁気記録媒体への情

第8図(B) は、情報書き込み駆動方法の説明図である。本発明になる磁気ヘッド素子を磁気記録媒体5上に、軟磁性体パタンの一端が近接する様に配置する。磁気記録媒体5には、磁気ヘッド素子からの磁束の通過効率を上げるために面内磁化層50が設けられている。軟磁性体パタン1の両端の巻線21及び22は、第8図(B) に示す如く接続線

25にて両端が同方向に磁化する様に接続されてい る。これに、パルス電流を比較的強く印加する と、磁衝性体パタンは一方向に磁化する。一方向 に磁性体バタンが磁化すると、その先端からは、 概 ね 触 和 磁 東 密 度 4 π Ks程 度 の 磁 界 45が 発 生 す る。NiFe合金の場合は、これはほぼ10,000Deとな る。このため磁気記録媒体は、その抗磁力Hcに勝 る外部磁界を受けて局所的にその磁化が反転した 磁区53が生じる。この磁区の大きさは、 ♥× b の オーダーである。この様にして、磁気ヘッド素子 と相対的に媒体5を一定の方向55に沿って移動さ せ、次々と磁区を書き込み、情報となす。この情 報書き込みの際に、軟磁性体パタン中央部巻線20 にも、同方向の磁化を生じせしめる方向の磁界発 生電流パルスを印加することは、軟磁性体パタン の飽和に対して一層の効果がある。

最後に本発明の磁気ヘッド素子の製造方法について第9図~第10図の素子断面図を用いて説明する。本発明の磁気ヘッド素子は、従来の第7図に示した薄膜磁気ヘッド素子と異なり、軟磁性体パ

タンが導体パタンでサンドイッチされている構造 - に特徴がある。従ってその製造方法も従来と違っ たものになる。即ち第9図に示す如く、基板材料 3上に第1の導体層を被着して露光・現像・エッ チングの工程を経て第1導体パタン31を形成す る. 次に例えばS102や Al203 の如き第1の絶縁 層 32を蒸着、スパッタ若くはプラズマCUD 法等の 方法で被着する。このままでは、第1導体パタン 31の有無により絶縁層に段差が生じていて、軟磁 性体パタンの形成に問題が生じる。従って絶縁層 32を被着後、スピンコート法若くはエッチバック 法を用いて平坦化を行なう。然る後に軟磁性体層 を真空蒸着法、スパッタ法若くはイオンピームデ ポジション法或いはメッキ法等にて被着し、露光 ・現像・エッチング等の加工工程を経て、軟磁性 体パタン1を形成する。又は、上記の工程を逆に して、レジスト材料の露光・現像・エッチング 後、軟磁性体層を被着し、リフトオフ法によりパ タン1を形成しても効果は同じである。次に、再 び第2の絶縁層33を、第1の絶縁層と同様な方法 で被着する。更に平坦化加工を施し、次いで第 2、第1の絶縁暦に第1の導体パタン層に達する パイア・ホール34をイオンミリング、RIE 法若く は化学エッチング法で形成する。最後に、第2の 導体層35を被着パターニングを行うと、そのバイ アホール34を介して、第1の導体パタン31と第2 の導体層とは電気接触がとれ、軟磁性体パタンの 囲りに巻線が完成する。

第10図(A) は、本発明の磁気ヘッド素子の製造 法の第2の実施例を示す。第2の絶縁層形成後、 バイアホールを加工する工程までは、第8図の場 合と同じである。その後、第1の導体パタン31を 電極にして、電気メッキ法若くは無電解メッキ法 で導体を被着すると、バイアホールの箇処34にの み事体が折出し、バイアホールを導体で埋めるこ とが出来る。次に、第2の層体パタン35を前述と 同様に被者・パターニングを行なうと、精度の良 い、巻線が完成する。

第10図(B) は、バイアホール34の導体での埋込 みが若干不足した場合を示している。この場合で

も、第2の層体パタン35の被着・パターニングに より、良好な巻線が行なえる。

#### (発明の効果)

以上に述べた様に、本発明を用いれば、非常に 高密度磁気記録に適した磁気ヘッド素子が提供さ れる。本発明の磁気ヘッド素子は、その高感度性 から、記録トラック幅Wを充分に小さくし得る。 単純な光学的露光、食刻技術でも1μm幅は充分 に実用的であり、2μm間隔で記録トラックを形 成することが可能となる。 更に、本発明の磁気へ ッド素子の狭トラック性を用いれば、磁気テープ への静止ヘッド型の多チャンネル記録が可能とな り、構造の簡単なVTR やPCM 録音装置が実現出来

#### 簡単な図面の説明

第1 図は本発明の基本形状図、第2図 (A)~ (C) 及び第3図は本発明の原理を示す図、第4 図、第5回は本発明の実施態様を示す図、第6回 は本発明の第2の実施態様を、第7回は従来の磁 気ヘッド第子を示す図、第8図は本発明磁気ヘッ

ド素子の駆動方法を示す図、第9図、第10図は、 本発明の素子の製造方法を説明する図である。

図に於いて、

1.1'… 軟磁性体パタン 2'… 巻線

3 … 基 板

5 … 磁気記錄媒体

6…センスアンプ

10…補助パタン

11.12 … 軟磁性体パタン端部

15… 磁壁

20…中央部のセンス巻線

21,22 … 端部卷線

25… 按統線

31… 第1 の導体パタン 32,33 … 絶縁層

34… バイアホール

35… 第2の導体パタン

41,42 … 外部磁界

43,44,45… 磁力線

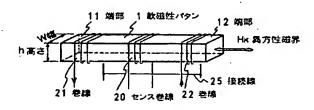
50…面内磁化層

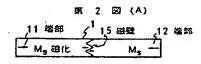
51,52,53,54 … 磁区

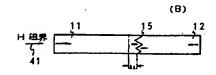
55… 媒体進行方向

を示す。



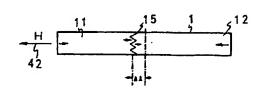


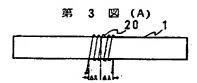


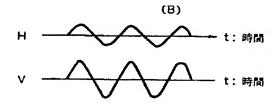


# 猜開昭63-31006 (**6**)

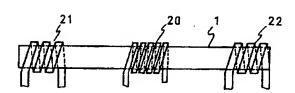
新 2 図 (C)

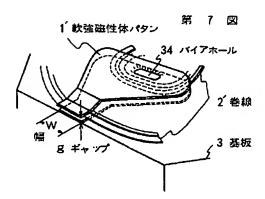




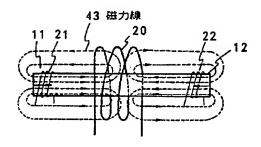


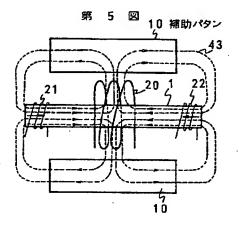
第 6 図



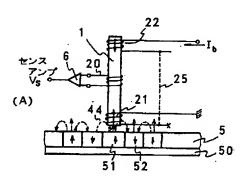


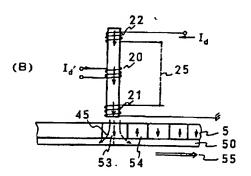
#### 第 4 図

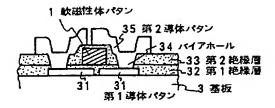


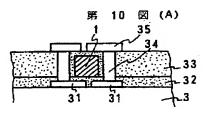


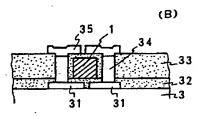
第 8 図











MITEUR PROBLEM SOUTH SHIT

THIS PAGE BLANK (USPTO)

## PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

63-031006

(43) Date of publication of application: 09.02.1988

(51)Int.CI.

G11B 5/127

(21)Application number : 61-174492

(71)Applicant : NEC CORP

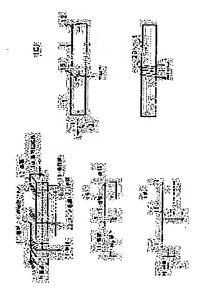
(22)Date of filing: 23.07.1986 (72)Inventor: URAI HARUO

# (54) MAGNETIC HEAD ELEMENT AND DRIVING METHOD AND ITS MANUFACTURE

#### (57)Abstract:

PURPOSE: To obtain the detained element to be able to increase a track density by applying a winding to both edge parts and the central part of a soft ferromagnetic substance pattern having one axial magnetic anisotropy in a long axial direction and a soft magnetic substance pattern.

CONSTITUTION: Windings 21 and 22 executed to both edge parts 11 and 12 of a magnetic substance pattern 1 are electrically connected and a direct electric current is impressed in an arrow direction. Then, magnetic substance pattern edge parts 11 and 12 are magnetized in the mutually different direction so that they are expressed by a magnetization Ms. When the density of the winding of both edge parts and the total number are equal, the strength of the magnetization comes to be equal and at the central part of the soft magnetic substance pattern, a magnetic wall 15 occurs. When a magnetic field H is impressed in the direction of an arrow 41 from the external part to the soft magnetic substance pattern of the condition, a magnetic domain having the direction of the magnetization coincident to the arrow 41 is grown and the magnetic wall 15 is shifted to [] I only. When the magnetic field H from the external part is impressed in the direction of an arrow 42, the magnetic wall 15 is shifted to UI in the reverse direction. The size of I can be adjusted by the strength of the impressed magnetic field. a winding 20 for a sense is provided at the scope to shift the



magnetic wall, namely, at the scope from the center of the soft magnetic substance pattern to a width 2[1] of  $\pm [1]$ , and the magnetization of the winding part is changed essentially to 2Ms. INSU MUNICED

#### **LEGAL STATUS**

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

THIS PAGE BLANK (USPTO)

(11) Japanese Unexamined Patent Application Publication No. 63-31006

Fig. 10(A) shows a second embodiment of a method for producing a magnetic head element according to the present invention. After the formation of the second insulating layer, the steps up to formation of the via hole are the same as those in Fig. 8. Subsequently, using a first conductor pattern 31 as an electrode, a conductor is deposited by an electroplating technique or an electroless plating technique such that the conductor deposits only in the via hole 34, thereby filling the via hole with the conductor. Next, the second layer pattern 35 is deposited and subjected to patterning as described above to make a winding with high accuracy.

Fig. 10(B) shows the case where the via hole 34 is not sufficiently filled with the conductor. In such a case also, satisfactory winding can be conducted by depositing and patterning the second layer pattern 35.

THIS PAGE BLANK (USPTO)